

Расчет силы, действующей на релятивистский электронный пучок, распространяющийся в плотной газоплазменной среде, со стороны омического плазменного канала

© А.С. Мануйлов

Санкт-Петербургский государственный университет, математико-механический факультет,
 Научно-исследовательский институт математики и механики им. В.И. Смирнова,
 198504 Санкт-Петербург, Россия
 e-mail: man06@mail.ru

(Поступило в Редакцию 31 января 2013 г.)

Рассмотрена задача о взаимодействии смещенного в поперечном направлении омического плазменного канала с параксиальным азимутально-симметричным релятивистским электронным пучком, распространяющимся в плотной газоплазменной среде. В рамках „жесткой“ модели пучка и канала получена формула для определения силы пучково-канального взаимодействия в случае произвольного смещения оси симметрии плазменного канала относительно соответствующей оси пучка. Проведено сравнение указанных сил, рассчитанных в беннетовском и гауссовском случаях радиальных профилей пучка и канала.

Введение

В последние годы новые области применения релятивистских электронных пучков (РЭП) делают актуальным дальнейшее исследование динамики транспортировки РЭП в плотных и разреженных газоплазменных средах [1–16]. Особый интерес в комплексе проблем, связанных с транспортировкой РЭП, представляет исследование методов стабильной проводки пучка по омическим и ионным плазменным каналам. В частности, в работах [10–13] рассмотрен ряд ситуаций, когда реализуется стабилизирующее влияние предварительно созданных плазменных каналов на транспортировку РЭП. В работе [10] были представлены результаты численного моделирования пучково-плазменного взаимодействия при транспортировке РЭП по омическим плазменным каналам с учетом генерации проводимости в результате ударной и лавинной ионизации фоновой газоплазменной среды. Для рассматриваемого случая было показано, что в головной части пучка имеет место электростатическое притяжение РЭП к каналу (так называемый трекинг пучка). Кроме того, в основной части РЭП наблюдается выталкивание пучка из плазменного канала. Очевидно, что последний эффект обусловлен увеличением проводимости в канале за счет ударной и лавинной ионизаций фонового газа и соответствующим ростом в окрестности оси канала обратного плазменного тока, который при развитии резистивной шланговой неустойчивости пучка играет дестабилизирующую роль [16].

В настоящей работе в рамках „жесткой“ модели пучка и канала проведен вывод формулы для расчета трекинги-силы, действующей на РЭП со стороны омического плазменного канала при произвольных амплитудах смещения оси симметрии пучка относительно соответствующей оси канала.

Постановка и решение задачи

Рассмотрим параксиальный моноэнергетический аксиально-симметричный РЭП с произвольным радиальным профилем плотности тока, распространяющийся в плотной газоплазменной среде по предварительно созданному омическому каналу с радиальным профилем проводимости $\sigma_{ch}(r)$ вдоль оси z цилиндрической системы координат (r, θ, z) . Ограничимся далее случаем высокой проводимости канала, когда выполнено условие полной нейтрализации пространственного заряда РЭП ($4\pi\sigma_{ch}(0)R_b/c \gg 1$, R_b — характерный радиус пучка, c — скорость света). Будем предполагать, что пучок не смещается относительно выбранной системы координат, а ось симметрии плазменного канала сносится в поперечном направлении на амплитуду $\mathbf{Y}_{ch} = Y_{ch}\mathbf{i}_y$, где \mathbf{i}_y — орт оси y , вдоль которой происходит смещение канала.

Тогда средняя сила, действующая на неподвижный РЭП со стороны вихревых токов, связанных со смещенным омическим каналом, и нормированная на релятивистскую энергию одного электрона пучка $m\gamma(\beta c)^2$, имеет вид

$$F = \frac{c}{I_b} \left(\frac{I_b}{I_A} \right) \int d\mathbf{r}_\perp \left(\mathbf{J}_{bz0}(\mathbf{r}_\perp) \times \mathbf{B}_\perp^{(p)} \right)_y, \quad (1)$$

где m — масса электрона, γ — его лоренц-фактор, $\beta = v_z/c$, v_z — продольная компонента скорости частиц пучка (она полагается одинаковой у всех электронов РЭП), c — скорость света, I_b — полный ток пучка, I_A — предельный ток Альфвена, \mathbf{r}_\perp — радиус-вектор в поперечной к оси z плоскости, проведенный из центра пучка, \mathbf{J}_{bz0} — проекция вектора равновесной плотности тока пучка на указанную ось, $\mathbf{B}_\perp^{(p)}$ — проекция вектора индукции магнитного поля, созданного вихревыми плазменными токами, на поперечную плоскость.

Кроме того, правая часть (1) может быть записана в другом виде

$$F = \frac{c}{I_b} \left(\frac{I_b}{I_A} \right) \int d\mathbf{r}_\perp J_{bz0}(\mathbf{r}_\perp) \frac{\partial A_z^{(p)}(\mathbf{S})}{\partial y}, \quad (2)$$

где $\mathbf{S} = \mathbf{r}_\perp - \mathbf{Y}_{ch}$, $A_z^{(p)}$ — z -компонента векторного потенциала электромагнитного поля, созданного возбужденными при смещении пучка индукционными плазменными токами.

Далее рассмотрим интеграл в правой части уравнения (2). Записывая частную производную по координате y через полярные координаты, находим

$$\begin{aligned} \Psi &\equiv \int d\mathbf{r}_\perp J_{bz0} \frac{\partial A_z^{(p)}(\mathbf{S})}{\partial y} \\ &= \int d\mathbf{r}_\perp J_{bz0}(\mathbf{r}_\perp) \left(\cos \theta \frac{\partial A_z^{(p)}(\mathbf{S})}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial A_z^{(p)}(\mathbf{S})}{\partial \theta} \right). \end{aligned} \quad (3)$$

Проведя интегрирование по частям, получим

$$\Psi = \int d\mathbf{r}_\perp J_{bz0}(\mathbf{r}) \cos \theta \left(\frac{\partial A_z^{(p)}(\mathbf{S})}{\partial r} + \frac{A_z^{(p)}(\mathbf{S})}{r} \right). \quad (4)$$

Рассмотрим далее ток пучка в трубке радиуса r в виде

$$I_{b0}(r) = 2\pi \int_0^r dr r J_{bz0}(r). \quad (5)$$

Кроме того, уравнение для $A_z^{(p)}$ можно представить в виде

$$\frac{\partial^2 A_z^{(p)}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_z^{(p)}}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 A_z^{(p)}}{\partial \theta^2} = -\frac{4\pi}{c} J_{pz}(\mathbf{S}). \quad (6)$$

Тогда очевидно, что

$$\begin{aligned} \Psi &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty dr I_{b0}(r) \\ &\times \int_0^{2\pi} d\theta \cos \theta \left[\frac{4\pi}{c} J_{pz}(\mathbf{S}) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 A_z^{(p)}(\mathbf{S})}{\partial \theta^2} + \frac{A_z^{(p)}(\mathbf{S})}{r^2} \right]. \end{aligned} \quad (7)$$

В силу равенства

$$\int_0^{2\pi} d\theta \cos \theta \frac{\partial^2 A_z^{(p)}}{\partial \theta^2} = - \int_0^{2\pi} d\theta \cos \theta A_z^{(p)}, \quad (8)$$

из (7) находим

$$\Psi = \frac{2}{c} \int_0^\infty dr I_{b0}(r) \int_0^{2\pi} d\theta \cos \theta J_{pz}(\mathbf{S}). \quad (9)$$

Тогда с учетом (2), (3) и (9) окончательно получим

$$F = \frac{2}{I_b^2} \left(\frac{I_b}{I_A} \right) \int_0^\infty dr I_{b0} \int_0^{2\pi} d\theta \cos \theta J_{pz}(\mathbf{S}). \quad (10)$$

Таким образом, средняя сила, действующая на пучок со стороны вихревых токов, генерируемых при поперечном смещении омического плазменного канала, определяется формулой (10).

Далее рассмотрим случай, когда РЭП и плазменный ток имеют беннетовский радиальный профиль с несовпадающими характерными радиусами или гауссовский профиль с разными радиусами. Для первого случая имеем

$$I_{b0}^{(B)}(r) = I_b \frac{r^2}{r^2 + R_b^2}, \quad (11)$$

и для средней силы получим следующее выражение:

$$\begin{aligned} F^{(B)}(\eta, Y_{ch1}) &= \frac{\alpha F_0}{\pi \eta^2} \int_0^\infty d\xi \frac{\xi^2}{1 + \xi^2} \\ &\times \int_0^{2\pi} d\theta \frac{\cos \theta}{[1 + (\xi^2 + Y_{ch1}^2 - 2Y_{ch1}\xi \cos \theta)/\eta^2]}, \end{aligned} \quad (12)$$

где $F_0 = 2|I_p|/(I_A R_b)$ — характерное значение рассматриваемой силы, I_p — полный плазменный ток, $\alpha = -1$, если $I_p < 0$ (вихревые токи в омическом канале направлены против тока пучка), $\alpha = 1$, если $I_p > 0$ (токи в канале направлены вдоль тока пучка), $Y_{ch1} = Y_{ch}/R_b$ — безразмерная амплитуда отклонения оси симметрии плазменного канала относительно соответствующей оси РЭП, $\eta = R_p/R_b$ — отношение характерного радиуса плотности плазменного тока к соответствующему радиусу пучка. Отметим, что если $I_p < 0$ ($\alpha = -1$), то рассматриваемая сила является детрекинг-силой (отталкивающей пучок от канала), в противном случае — трекинг-силой (возвращающей силой).

В случае гауссовского радиального профиля плотности тока РЭП находим

$$I_{b0}^{(G)}(r) = I_b \left[1 - \exp\left(-\frac{r^2}{R_b^2}\right) \right]. \quad (13)$$

Тогда в ситуации аналогичного профиля канальной проводимости для средней силы, действующей на пучок со стороны плазменных токов, получим выражение

$$\begin{aligned} F^{(G)}(\eta, Y_{ch1}) &= \frac{\alpha F_0}{\pi \eta^2} \int_0^\infty d\xi \exp(1 - \xi^2) \\ &\times \int_0^{2\pi} d\theta \cos \theta \exp\left(-\frac{\xi^2 + Y_{ch1}^2 - 2Y_{ch1}\xi \cos \theta}{\eta^2}\right). \end{aligned} \quad (14)$$

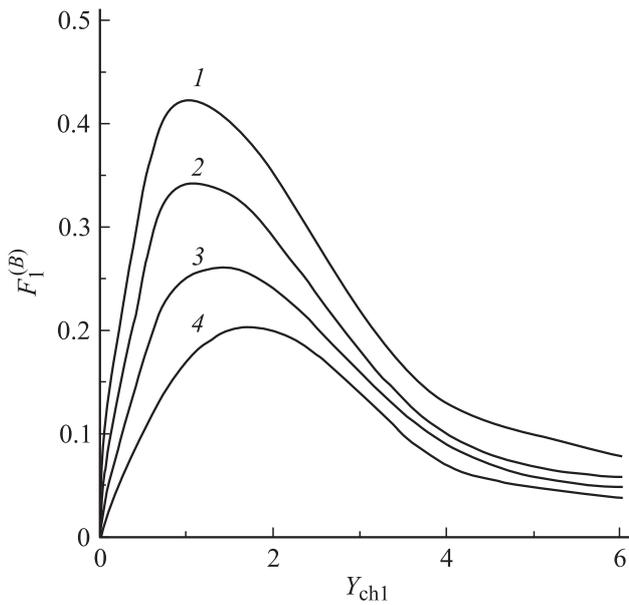


Рис. 1. График зависимости $F_1^{(B)} = |F^{(B)}|/F_0$ от безразмерной амплитуды отклонения плазменного канала Y_{ch1} . Кривая 1 — $\eta = 0.3$, 2 — 0.6, 3 — 1, 4 — 1.5.

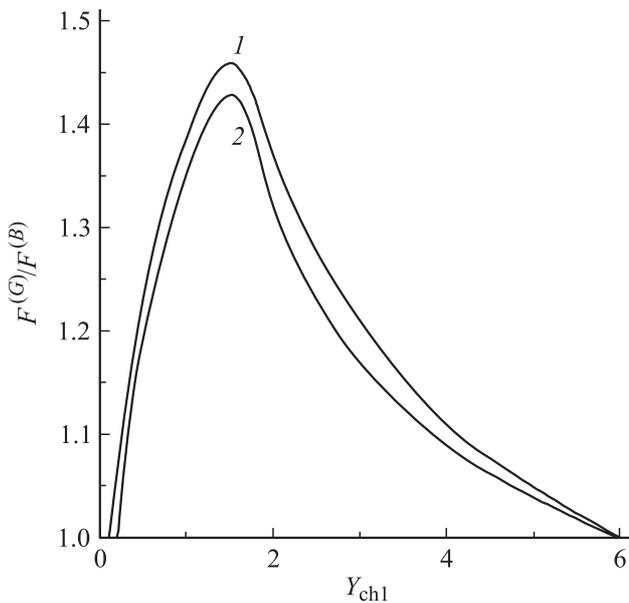


Рис. 2. График зависимости $F^{(G)}/F^{(B)}$ от амплитуды Y_{ch1} . Кривая 1 — $\eta = 0.3$, 2 — 0.6.

На рис. 1 представлены рассчитанные с помощью формулы (12) (для беннетовского случая) зависимости безразмерной трекинг-силы $F_1^{(B)} = |F^{(B)}|/F_0$ от нормированной амплитуды Y_{ch1} отклонения оси симметрии омического плазменного канала от соответствующей оси пучка при разных значениях параметра $\eta = R_p/R_b$. Кривая 1 соответствует случаю $\eta = 0.3$, 2 — 0.6, 3 — 1, 4 — 1.5.

На рис. 2 приведены зависимости $\Psi = F^{(G)}/F^{(B)}$ от Y_{ch1} . Кривая 1 соответствует случаю $\eta = 0.3$, 2 — 0.6. Графики показывают, что для гауссовского случая рассматриваемая сила в своем максимуме почти в 1.5 раза выше, чем соответствующая сила для беннетовской ситуации.

Заключение

Таким образом, полученные результаты показывают, что рассматриваемая сила может быть отталкивающей (детрекинг-силой), когда выполнено условие $I_p < 0$ (плазменные токи в омическом канале направлены против тока пучка) и силой возвращающей (трекинг-силой) в противном случае. Кроме того, при убывании параметра $\eta = R_p/R_b$, характеризующего отношение характерного радиуса плотности плазменного тока к соответствующему радиусу пучка, сила пучково-канального взаимодействия увеличивается по величине. Это объясняется тем, что при этом большая часть плазменных токов оказывается вне области, занятой пучком, что работает на увеличение либо силы отталкивания (при $\alpha = -1$), либо силы притяжения (когда $\alpha = 1$).

Работа выполнена в рамках Тематического плана фундаментальных НИР, выполняемых СПбГУ по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации № 6.0.10.2010.

Список литературы

- [1] Рухадзе А.А., Богданкевич Л.С., Росинский С.Е., Рухлин В.Г. Физика сильноточных релятивистских электронных пучков. М.: Атомиздат, 1980. 167 с.
- [2] Диденко А.Н., Григорьев В.П., Усов Ю.П. Мощные электронные пучки и их применение. М.: Атомиздат, 1977. 277 с.
- [3] Кузелев М.В., Рухадзе А.А. Электродинамика плотных электронных пучков в плазме. М.: Физматлит, 1990. 336 с.
- [4] Миллер Р. Введение в физику сильноточных пучков заряженных частиц. М.: Мир, 1984. 432 с.
- [5] Колесников Е.К., Мануйлов А.С., Филиппов Б.В. Динамика пучков заряженных частиц в газоплазменных средах. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. 98 с.
- [6] Lee E.P. // Phys. Fluids. 1978. Vol. 21. N 8. P. 1327–1343.
- [7] Надеждин Е.Р., Сорокин Г.А. // Физика плазмы. 1983. Т. 9. N 5. С. 989–991.
- [8] Мануйлов А.С. // ЖТФ. 2000. Т. 70. Вып. 1. С. 76–78.
- [9] Колесников Е.К., Мануйлов А.С. // ЖТФ. 1991. Т. 61. Вып. 12. С. 43–46.
- [10] Hui B., Lampe M. // Proc. Fifth Int. Conf. High Power Particle Beams. San Francisco, 1983. P. 374–377.
- [11] Welch D.R., Bieniosek F.M., Godfrey B.B. // Phys. Rev. Lett. 1990. Vol. 65. N 25. P. 3128–3131.

- [12] *Fernster R.F., Slinker S.P., Hubbard R.F.* // Phys. Fluids. B. 1991. Vol. 3. N 9. P. 2696–2706.
- [13] *Murphy D.P., Pechacek R.E., Taggart D.P.* et al. // Phys. Fluids. B. 1992. Vol. 4. N 10. P. 3407–3417.
- [14] *Кондратьев Н.А., Сметанин В.И.* // ЖТФ. 2005. Т. 75. Вып. 3. С. 67–73.
- [15] *Колесников Е.К., Мануйлов А.С.* // ЖТФ. 1997. Т. 67. Вып. 12. С. 78–80.
- [16] *Lampe M., Sharp W.M., Hubbard R., Lee E.P.* et al. // Phys. Fluids. 1984. Vol. 27. N 12. P. 2921–2936.